

	<p><b>SIS892ADN-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS892ADN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 28A PPAK 1212</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS892ADN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 15015 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIS892ADN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 28A PPAK 1212
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	15015 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS892ADN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 28A (Tc) 3.7W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Tc)

SIS892ADN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS892ADN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS892ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS892ADN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS888DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 20.2A 1212-8S</p>	 <p><b>SIS890DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 30A 1212-8</p>	 <p><b>SIS892ADN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 28A PPAK 1212</p>	 <p><b>SIS890DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 30A 1212-8</p>
 <p><b>SIS892DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 30A 1212-8 PPAK</p>	 <p><b>SIS892DN-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p><b>SIS892ADN-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p><b>SIS888DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 20.2A 1212-8S</p>

### SIS892ADN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SIS892ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS892ADN-T1-GE3 Datenblatt	SIS892ADN-T1-GE3-Datenblätter	SIS892ADN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS892ADN-T1-GE3
SIS892ADN-T1-GE3 Electronic	SIS892ADN-T1-GE3-Komponenten	SIS892ADN-T1-GE3-Verteiler	SIS892ADN-T1-GE3-Bild	SIS892ADN-T1-GE3-Teil
SIS892ADN-T1-GE3 Preis	SIS892ADN-T1-GE3 Hersteller	SIS892ADN-T1-GE3 Bild	SIS892ADN-T1-GE3 Aktie	SIS892ADN-T1-GE3 Inventar
SIS892ADN-T1-GE3 Neu	SIS892ADN-T1-GE3 Original	SIS892ADN-T1-GE3 garantiert	SIS892ADN-T1-GE3 RFQ	SIS892ADN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited